

P 型非晶氧化物半導體原子層沈積系統

儀器簡介

沉積多種氧化物薄膜以及表面電漿處理。

- ❖ 全名: P 型非晶氧化物半導體原子層沈積系統
- ❖ 位置: L413 先進薄膜實驗室
- ❖ 機台工程師: 呂俊毅 博士
- ❖ 工程師緊急聯絡電話: (O) 886-3-5773693 ext 7510
- ❖ 工程師代理人: 洪子杰 先生
- ❖ 代理工程師緊急聯絡電話: (O) 886-3-5712121 ext 58521
- ❖ 機台使用之化學品:
 - (1) 大宗氣體: N_2 , O_2 , Ar
 - (2) 特殊氣體: NH_3
 - (3) 瓶裝化學品: TMA, TMAHf, Sn 前驅物
- ❖ 製程模式或反應腔: 化學氣相沉積
- ❖ 反應腔真空度範圍: 5~10 hPa
- ❖ 抽真空泵浦: Edwards iXH610
- ❖ 尾氣排放物種: CHN 有機化合物
- ❖ 尾氣排放有無獨立之 Local Scrubber: 有, 廠務端提供
- ❖ 反應腔溫度範圍: 150~400 °C
- ❖ 冷卻系統種類: 廠務供應冷卻水
- ❖ 其他特殊危害: 前驅物為易燃劇毒物質
- ❖ 製造商或代理商: 新元鋒精密股份有限公司
- ❖ 製造商工程師: 黃政億
- ❖ 更新日期: 6 (月)/ 18 (日)/ 2026 (年)